

Prof.Dr. ABDULMECİT TÜRÜT

Kişisel Bilgiler

İş Telefonu: [+90 216 280 3402](tel:+902162803402)

E-posta: abdulmecit.turut@medeniyet.edu.tr

Diğer E-posta: amecit2002@yahoo.com

Web: <http://aves.medeniyet.edu.tr/abdulmecit.turut/>

Posta Adresi: amecit2002@yahoo.com
abdulmecit.turut@medeniyet.edu.tr

Eğitim Bilgileri

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Türkiye 1981 - 1987

Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye 1976 - 1980

Yaptığı Tezler

Doktora, Nötronlarla Işınlanmış p-Tipi Silisyumun Bazı Elektronik Özellikleri, Atatürk Üniversitesi, Fbe, Fizik, 1987

Araştırma Alanları

Fizik, Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler, Yoğun maddede elektronik taşınım, Temel Bilimler

Mesleki Deneyim

Bölüm Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Mühendisliği, 2012 - Devam Ediyor

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2012 - Devam Ediyor

BAP Bilimsel Komisyon Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2012 - 2015

Senato Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2012 - 2014

Enstitü Müdürü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2012 - 2014

Bölüm Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik, 2009 - 2012

Verdiği Dersler

Fizik II-Elektrik ve Manyetizma, Lisans, 2011 - 2012

Fizik I-Mekanik, Lisans, 2010 - 2011

Kathal Elektronik, Doktora, 2009 - 2010

Kathal Teorisi, Yüksek Lisans, 2009 - 2010

Titreşimler ve Dalgalar Dersi, Lisans, 2009 - 2010

Klasik Mekanik, Lisans, 2006 - 2007

Yönetilen Tezler

TÜRÜT A., SAÇTIRMA YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN Ni/n-GaAs SCHOTTKY DİYOTLARIN SICAKLIĞA BAĞLI AKIM-VOLTAJ VE KAPASİTE-VOLTAJ KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, A.GÜZEL(Öğrenci), 2012

TÜRÜT A., MAGNETRON SPUTTER YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN METAL/p-InP SCHOTTKY DİYOTLARIN KARAKTERİSTİK PARAMETRELERİNİN TAVLAMA VE NUMUNE SICAKLIĞINA BAĞLI DEĞİŞİMLERİ, Doktora,

K.EJDERHA(Öğrenci), 2011

TÜRÜT A., Metal/p-InP/Metal Schottky Kontakların Akım-Kapasite-Gerilim Karakteristiklerinin Metal İş Fonksiyonuna Bağlılığının İncelenmesi, Doktora, S.ASUBAY(Öğrenci), 2009

TÜRÜT A., AYNI ŞARTLARDA HAZIRLANAN Cr/n-GaAs SCHOTTKY KONTAKLARINDA NUMUNE SICAKLIĞINA BAĞLI T0 ANORMALLIĞININ ISIL TAVLAMAYLA İMLEŞTİRİLMESİ, Doktora, H.KORKUT(Öğrenci), 2009

TÜRÜT A., SAÇTIRMA YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN Ni/n-GaAs SCHOTTKY ENGEL DİYOTLARIN DENEYSEL AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE NUMUNE SICAKLIĞININ VE ISIL TAVLAMANIN ETKİLERİ, Doktora, N.YILDIRIM(Öğrenci), 2008

TÜRÜT A., ISIL OLARAK TAVLANMIŞ Ni/n-GaAs/In SCHOTTKY DİYOTLARIN DENEYSEL KARAKTERİSTİKLERİNİN ENGEL İNHOMOJENLİK MODELİNE GÖRE BELİRLENMESİ, Doktora, H.DOĞAN(Öğrenci), 2007

TÜRÜT A., Ag/- Al/- Au/- Cu/- Fe/-nGaAs SCHOTTKY DİYOTLARDA ANODİK OKSİDASYONLA YÜZEY PASİVASYONU VE ANODİK OKSİDASYONLU MIS DİYOTLARIN FABRİKASYONU, Doktora, M.BİBER(Öğrenci), 2000

TÜRÜT A., İDEAL VE İDEAL OLMAYAN OMİK VE DOĞRULTUCU KONTAKLI Au/n-Si SCHOTTKY DİYOTLARDA DOĞRU BESLEM KAPASİTE-VOLTAJ-FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ, Doktora, B.BATI(Öğrenci), 1999

TÜRÜT A., Al/Anodik SiO2/Si (MOS) yapıların elektriksel özellikleri üzerine ısıl tavlama, akım yoğunluğu ve elektrolit pH 'ının etkileri", Doktora, M.SAĞLAM(Öğrenci), 1994

TÜRÜT A., Al/n-Si Schottky diyodlarının ideal olmayan I-V, C-V karakteristikleri ve arayüzey hallerinin enerji dağılımı., Yüksek Lisans, M.SAĞLAM(Öğrenci), 1991

Jüri Üyelikleri

Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı 2012, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Aralık, 2012

Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı 2012, Dokuz Eylül Üniversitesi, Aralık, 2012

Akademik Kadroya Atama, Yard.Doç. Kadrosuna atanma 2012, Atatürk Üniversitesi, Kasım, 2012

Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı 2012, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kasım, 2012

Akademik Personel Sınavı, Doçentlik Kadrosuna Atanma 2012, Bingöl Üniversitesi, Kasım, 2012

Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı 2012, Pamukkale Üniversitesi, Ekim, 2012

Akademik Kadroya Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma 2012, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Ekim, 2012

Akademik Kadroya Atama, Profesörlük Kadrosuna Atanma 2012, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, Eylül, 2012

Akademik Kadroya Atama, PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATAMA 2012, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Eylül, 2012

Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı 2012, Aksaray Üniversitesi, Haziran, 2012

Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı 2012, Ahi Evran Üniversitesi, Haziran, 2012

Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı 2012, Hitit Üniversitesi, Haziran, 2012

Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı 2012, Muğla Üniversitesi, Haziran, 2012

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- **Synthesis, characterization and wide range frequency and temperature dependent electrical modulus study of LaCrO3 and cobalt (Co) doped LaCrO3 perovskite compounds**

Coşkun M., Polat Ö., Coşkun F. M. , Durmuş Z., Çağlar M., Türüt A.

Materials Science And Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials, cilt.248, ss.114410-114424, 2019

- **An experimental investigation: The impact of cobalt doping on optical properties of YbFeO3-σ thin film**

Polat Ö., Çağlar M., Coşkun F. M. , Coşkun M., Çağlar Y., Türüt A.

Materials Research Bulletin, cilt.119, ss.110567-110576, 2019

- **Electrical characterization of Ir doped rare-earth orthoferrite YbFeO3**

polat o., COŞKUN M., COŞKUN F. M. , Kurt B. Z. , durmus z., caglar y., caglar m., TÜRÜT A.

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.787, ss.1212-1224, 2019

- **The current-voltage characteristics of the ferroelectric p-YMnO3 thin film/bulk p-Si heterojunction over a broad measurement temperature range**

Türüt A., Coşkun M., Coşkun F. M. , Polat Ö., Durmuş Z., Çağlar M., Efeoğlu H.

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.782, ss.566-575, 2019

- **Effect of Os doping on electrical properties of YMnO₃ multiferroic perovskite-oxide compounds**

Coskun M., Polat Ö., Coskun F. M., Durmuş Z., Çağlar M., Turut A.

MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.91, ss.281-289, 2019

- **Tailoring the band gap of ferroelectric YMnO₃ through tuning the Os doping level**

POLAT Ö., COŞKUN F. M., COŞKUN M., durmuş z., çağlar y., çağlar m., TÜRÜT A.

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.30, ss.3443-3451, 2019

- **Co doped YbFeO₃ : exploring the electrical properties via tuning the doping level**

Polat Ö., Coskun M., Coskun F., Zlamal J., Kurt B. Z., Durmuş Z., Çağlar M., Turut A.

Ionics, 2019

- **Temperature-dependent electrical characteristics of Alq₃/p-Si heterojunction**

KARABULUT A., Orak I., Canli S., YILDIRIM N., TÜRÜT A.

PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.550, ss.68-74, 2018

- **The characterization of electrical properties of Pd-doped LaCrO₃ perovskite structure**

Polat O., COŞKUN M., COŞKUN F. M., durmuş z., Caglar M., TÜRÜT A.

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.29, ss.16939-16955, 2018

- **Os doped YMnO₃ multiferroic: A study investigating the electrical properties through tuning the doping level**

Polat O., COŞKUN M., COŞKUN F. M., durmuş z., Caglar M., TÜRÜT A.

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.752, ss.274-288, 2018

- **CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS OF THERMALLY ANNEALED Ni/n-GaAs SCHOTTKY CONTACTS**

YILDIRIM N., TÜRÜT A., DOĞAN H.

SURFACE REVIEW AND LETTERS, cilt.25, 2018

- **The photovoltaic impact of atomic layer deposited TiO₂ interfacial layer on Si-based photodiodes**

KARABULUT A., Orak I., TÜRÜT A.

SOLID-STATE ELECTRONICS, cilt.144, ss.39-48, 2018

- **The electrical and dielectric properties of the Au/Ti/HfO₂/n-GaAs structures**

KARABULUT A., TÜRÜT A., KARATAŞ Ş.

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, cilt.1157, ss.513-518, 2018

- **Frequency and temperature dependent electrical and dielectric properties of LaCrO₃ and Ir doped LaCrO₃ perovskite compounds**

COŞKUN M., Polat O., COŞKUN F. M., durmuş z., Caglar M., TÜRÜT A.

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.740, ss.1012-1023, 2018

- **Engineering the band gap of LaCrO₃ doping with transition metals (Co, Pd, and Ir)**

Polat O., Durmuş Z., COŞKUN F. M., COŞKUN M., TÜRÜT A.

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, cilt.53, ss.3544-3556, 2018

- **Temperature dependent dielectric properties of Au/ZnO/n-Si heterojunction**

KOÇYİĞİT A., Orak I., TÜRÜT A.

MATERIALS RESEARCH EXPRESS, cilt.5, 2018

- **The electrical modulus and other dielectric properties by the impedance spectroscopy of LaCrO₃ and LaCr_{0.90}Ir_{0.10}O₃ perovskites**

COŞKUN M., Polat O., COŞKUN F. M., Durmuş Z., Caglar M., TÜRÜT A.

RSC ADVANCES, cilt.8, ss.4634-4648, 2018

- **Synthesis and Characterization of Reduced Graphene Oxide/Rhodamine 101 (rGO-Rh101) Nanocomposites and Their Heterojunction Performance in rGO-Rh101/p-Si Device Configuration**

Batir G. G., ARIK M., Caldiran Z., TÜRÜT A., AYDOĞAN Ş.

JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, cilt.47, ss.329-336, 2018

- **Electrical and photovoltaic properties of Ag/p-Si structure with GO doped NiO interlayer in dark and under light illumination**

Ozerli H., Bekereci A., TÜRÜT A., Karatas S.

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.718, ss.75-84, 2017

- **COMPARISON OF THE Ti/n-GaAs SCHOTTKY CONTACTS' PARAMETERS FABRICATED USING DC**

MAGNETRON SPUTTERING AND THERMAL EVAPORATION

KAHVECİ O., Akkaya A., AYYILDIZ E., Turut A.

SURFACE REVIEW AND LETTERS, cilt.24, 2017

- **THE CHARACTERISTIC DIODE PARAMETERS IN Ti/p-InP CONTACTS PREPARED BY DC SPUTTERING AND EVAPORATION PROCESSES OVER A WIDE MEASUREMENT TEMPERATURE**
Ejderha K., Asubay S., Yıldırım N., Gullu O., TÜRÜT A., ABAY B.
SURFACE REVIEW AND LETTERS, cilt.24, 2017
- **The Characteristic Parameters of Ni/n-6H-SiC Devices Over a Wide Measurement Temperature Range**
Ejderha K., Karabulut A., TURKAN N., TÜRÜT A.
SILICON, cilt.9, ss.395-401, 2017
- **Temperature-dependent C-V characteristics of Au/ZnO/n-Si device obtained by atomic layer deposition technique**
Kocyyigit A., Orak I., AYDOĞAN Ş., Caldiran Z., TÜRÜT A.
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.28, ss.5880-5886, 2017
- **The surface morphology properties and respond illumination impact of ZnO/n-Si photodiode by prepared atomic layer deposition technique**
Orak I., Kocyyigit A., TÜRÜT A.
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.691, ss.873-879, 2017
- **The influence of annealing temperature and time on the efficiency of pentacene: PTCDI organic solar cells**
BİBER M., AYDOĞAN Ş., Caldiran Z., ÇAKMAK B., Karacali T., TÜRÜT A.
RESULTS IN PHYSICS, cilt.7, ss.3444-3448, 2017
- **The performance of the anthraquinone/p-Si and the pyridine/p-Si rectifying device under X-ray irradiation**
ŞAHİN Y., AYDOĞAN Ş., EKİNCİ D., TÜRÜT A.
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, cilt.183, ss.516-523, 2016
- **Electronic Transport of an Ni/n-GaAs Diode Analysed Over a Wide Temperature Range**
Guzel A., Duman S., Yıldırım N., TÜRÜT A.
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, cilt.45, ss.2808-2814, 2016
- **Electrical and photoelectrical properties of Ag/n-type Si metal/semiconductor contact with organic interlayer**
Ozerden E., Ocak Y. S., Tombak A., Kilicoglu T., TÜRÜT A.
THIN SOLID FILMS, cilt.597, ss.14-18, 2015
- **Optical absorption of the anthracene and temperature-dependent capacitance-voltage characteristics of the Au/anthracene/n-Si heterojunction in metal-organic-semiconductor configuration**
Kacus H., AYDOĞAN Ş., EKİNCİ D., Kurudirek S. V., TÜRÜT A.
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES, cilt.74, ss.505-509, 2015
- **Capacitance-conductance-current-voltage characteristics of atomic layer deposited Au/Ti/Al₂O₃/n-GaAs MIS structures**
TÜRÜT A., Karabulut A., Ejderha K., Biyikli N.
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.39, ss.400-407, 2015
- **The electrical characterizations and illumination response of Co/N-type GaP junction device**
Orak I., Ejderha K., TÜRÜT A.
CURRENT APPLIED PHYSICS, cilt.15, ss.1054-1061, 2015
- **The interface state density characterization by temperature-dependent capacitance-conductance-frequency measurements in Au/Ni/n-GaN structures**
TÜRÜT A., Dogan H., Yıldırım N.
MATERIALS RESEARCH EXPRESS, cilt.2, 2015
- **Electronic Properties of Cu/n-InP Metal-Semiconductor Structures with Cytosine Biopolymer**
Gullu O., TÜRÜT A.
ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.128, ss.383-388, 2015
- **Electronic parameters of MIS Schottky diodes with DNA biopolymer interlayer**
GÜLLÜ Ö., TÜRÜT A.
MATERIALS SCIENCE-POLAND, cilt.33, ss.593-600, 2015

- **Temperature-dependent current-voltage measurements of Au/C9H7N/p-Si: Characterization of a metal-organic-semiconductor device**
Caldiran Z., AYDOĞAN Ş., Yesildag A., EKİNCİ D., Kurudirek S. V. , TÜRÜT A.
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.34, ss.58-64, 2015
- **Preparation and characterization of sol-gel-derived n-ZnO thin film for Schottky diode application**
YILMAZ M., Caldiran Z., Deniz A. R. , AYDOĞAN Ş., Gunturkun R., Turut A.
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, cilt.119, ss.547-552, 2015
- **Determination of the some electronic parameters of nanostructure copper selenide and Cu/Cu₃Se₂/n-GaAs/In structure**
GÜZELDİR B., SAĞLAM M., Ates A., TÜRÜT A.
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.627, ss.200-205, 2015
- **The origin of forward bias capacitance peak and voltage dependent behaviour of gold/p-type indium phosphide Schottky barrier diode fabricated by photolithography**
Korucu D., Duman S., TÜRÜT A.
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.30, ss.393-399, 2015
- **The comparison of electrical characterizations and photovoltaic performance of Al/p-Si and Al/Azure C/p-Si junctions devices**
Orak I., TÜRÜT A., Toprak M.
SYNTHETIC METALS, cilt.200, ss.66-73, 2015
- **Capacitance-conductance-frequency characteristics of Au/Ni/n-GaN/undoped GaN Structures**
Dogan H., Yildirim N., Orak I., Elagoz S., TÜRÜT A.
PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.457, ss.48-53, 2015
- **The effect of annealing temperature on the electrical characterization of Co/n type GaP Schottky diode**
Orak I., Ejderha K., SÖNMEZ E., ALANYALIOĞLU M., TÜRÜT A.
MATERIALS RESEARCH BULLETIN, cilt.61, ss.463-468, 2015
- **Current-Voltage and Capacitance-Conductance-Voltage Characteristics of Al/SiO₂/p-Si and Al/Methyl Green (MG)/p-Si Structures**
Duman S., Ozcelik F. S. , GÜRBULAK B., GÜLNAHAR M., TÜRÜT A.
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE, ss.347-353, 2015
- **Effect of temperature on the current (capacitance and conductance)-voltage characteristics of Ti/n-GaAs diode**
Ejderha K., Duman S., NUHOĞLU Ç., Urhan F., TÜRÜT A.
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, cilt.116, 2014
- **On the electrical characteristics of the Al/rhodamine-101/p-Si MS structure at low temperatures**
Karatas S., Cakar M., TÜRÜT A.
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.28, ss.135-143, 2014
- **International Semiconductor Science and Technology Conference, ISSTC-2014**
Turut A.
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.28, ss.1, 2014
- **Temperature-dependent current-voltage characteristics in thermally annealed ferromagnetic Co/n-GaN Schottky contacts**
Ejderha K., Yildirim N., TÜRÜT A.
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, cilt.68, 2014
- **Temperature dependence of Schottky diode characteristics prepared with photolithography technique**
Korucu D., TÜRÜT A.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, cilt.101, ss.1595-1606, 2014
- **Illumination impact on the electrical characterizations of an Al/Azure A/p-Si heterojunction**
Orak I., Toprak M., TÜRÜT A.
PHYSICA SCRIPTA, cilt.89, 2014
- **Electrical characteristics of Au/Ti/n-GaAs contacts over a wide measurement temperature range**
Biyikli N., Karabulut A., Efeolu H., GÜZELDİR B., TÜRÜT A.
PHYSICA SCRIPTA, cilt.89, 2014

- **Electrical properties and interface state energy distributions of Cr/n-Si Schottky barrier diode**
Karatas S., Yildirim N., TÜRÜT A.
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES, cilt.64, ss.483-494, 2013
- **Temperature dependent current-transport mechanism in Au/(Zn-doped)PVA/n-GaAs Schottky barrier diodes (SBDs)**
Tecimer H., TÜRÜT A., Uslu H., Altindal S., Uslu I.
SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, cilt.199, ss.194-201, 2013
- **The origin of negative capacitance in Au/n-GaAs Schottky barrier diodes (SBDs) prepared by photolithography technique in the wide frequency range**
Korucu D., TÜRÜT A., Altindal S.
CURRENT APPLIED PHYSICS, cilt.13, ss.1101-1108, 2013
- **Analysis of interface states and series resistances in Au/p-InP structures prepared with photolithography technique**
KORUCU D., Karataş Ş., TÜRÜT A.
INDIAN JOURNAL OF PHYSICS, cilt.87, ss.733-740, 2013
- **THE CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS OF THE Au/MBE n-GaAs SCHOTTKY DIODES IN A WIDE TEMPERATURE RANGE**
EFEOĞLU H., TÜRÜT A.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, cilt.27, 2013
- **Origin of forward bias capacitance peak and intersection behavior of C and G/w of Ag/p-InP Schottky barrier diodes**
Korucu D., TÜRÜT A., TURAN R., Altindal S.
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.16, ss.344-351, 2013
- **Temperature dependent I-V characteristics of an Au/n-GaAs Schottky diode analyzed using Tung's model**
Korucu D., TÜRÜT A., EFEOĞLU H.
PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.414, ss.35-41, 2013
- **Evaluation of lateral barrier height of inhomogeneous photolithography-fabricated Au/n-GaAs Schottky barrier diodes from 80 K to 320 K**
Korucu D., EFEOĞLU H., Turut A., Altindal S.
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.15, ss.480-485, 2012
- **Effect of temperature on the capacitance-frequency and conductance-voltage characteristics of polyaniline/p-Si/Al MIS device at high frequencies**
Aydoğan Ş., Sağlam M., TÜRÜT A.
MICROELECTRONICS RELIABILITY, cilt.52, ss.1362-1366, 2012
- **Determination of contact parameters of Ni/n-GaP Schottky contacts**
Duman S., Ejderha K., Yigit O., TÜRÜT A.
MICROELECTRONICS RELIABILITY, cilt.52, ss.1005-1011, 2012
- **E High barrier Schottky diode with organic interlayer**
Güllü Ö., Aydoğan Ş., TÜRÜT A.
Solid State Communications, cilt.152, 2012
- **Current density-voltage analyses and interface characterization in Ag/DNA/p-InP structures**
Gullu O., Pakma O., Turut A.
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, cilt.111, 2012
- **Temperature dependent negative capacitance behavior of Al/rhodamine-101/n-GaAs Schottky barrier diodes and Rs effects on the C-V and (G/w)-V characteristics**
Vural Ö. F. , Şafak Y., TÜRÜT A., Altindal Ş.
Journal of Alloys and Compounds, cilt.513, 2012
- **Electronic parameters of high barrier Au/Rhodamine-101/n-Inp Schottky diode with organic interlayer**
Güllü Ö., Aydoğan Ş., TÜRÜT A.
THIN SOLID FILMS, cilt.520, ss.1944-1948, 2012
- **Temperature-dependent I-V characteristics in thermally annealed Co/p-InP contacts**
Ejderha K., Yildirim N., TÜRÜT A., Abay B.

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, cilt.57, 2012

- **The effects of 12 MeV electron irradiation on the electrical characteristics of the Au/Aniline blue/p-Si/Al device**
Aydoğan Ş., İncekara Ü., TÜRÜT A.
MICROELECTRONICS RELIABILITY, cilt.51, ss.2216-2222, 2011
- **Effects of ageing on the electrical characteristics of Cd/CdS/n-Si/Au-Sb structure deposited by SILAR method**
Güzeldir B., Sağlam M., Ateş A., TÜRÜT A.
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, cilt.72, ss.1506-1514, 2011
- **Influence of 12 MeV electron irradiation on the electrical and photovoltaic properties of Schottky type solar cell based on Carmine**
Aydoğan Ş., TÜRÜT A.
RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, cilt.80, ss.869-875, 2011
- **The effect of electron irradiation on the electrical characteristics of the Aniline Blue/n-Si/Al device**
Aydoğan Ş., Şerifoğlu K., TÜRÜT A.
SOLID STATE SCIENCES, cilt.13, ss.1369-1374, 2011
- **Responses of Pt/n-InP Schottky diode to electron irradiation in different temperature conditions**
Akbaş A., Korkut H., Ejderha K., Korkut T., TÜRÜT A.
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.289, ss.145-148, 2011
- **Temperature dependent current-voltage and capacitance-voltage characteristics of chromium Schottky contacts formed by electrodeposition technique on n-type Si**
TÜRÜT A., Demircioğlu Ö., Karataş Ş., Yıldırım N., Bakkaloğlu Ö. F.
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.509, ss.6433-6439, 2011
- **Capacitance and conductance-frequency characteristics of Au-Sb/p-GaSe:Gd Schottky barrier diode**
Duman S., Gürbulak B., Doğan S., TÜRÜT A.
Vacuum, cilt.85, 2011
- **Electrical and optical characteristics of Au/PbS/n-6H-SiC structures prepared by electrodeposition of PbS thin film on n-type 6H-SiC substrate**
Gülen Y., Alanyaloğlu M., Ejderha K., Nuhoğlu Ç., TÜRÜT A.
Journal of Alloys and Compounds, cilt.509, 2011
- **Dependence of characteristic diode parameters on sample temperature in Ni/epitaxy n-Si contacts**
Ejderha K., Zengin A., Orak İ., Taşyürek B., TÜRÜT A.
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.14, ss.5-12, 2011
- **Schottky barrier height modification in Au/n-type 6H-SiC structures by PbS interfacial layer**
Gülen Y., Ejderha K., Nuhoğlu Ç., TÜRÜT A.
MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.88, ss.179-182, 2011
- **Electronic properties of Al/DNA/p-Si MIS diode: Application as temperature sensor**
Güllü Ö., TÜRÜT A.
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.509, ss.571-577, 2011
- **On temperature-dependent experimental I-V and C-V data of Ni/n-GaN Schottky contacts**
Yıldırım N., Ejderha K., TÜRÜT A.
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, cilt.108, 2010
- **Electrical analysis of organic dye-based MIS Schottky contacts**
Güllü Ö., TÜRÜT A.
MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.87, ss.2482-2487, 2010
- **Extraction of electronic parameters of Schottky diode based on an organic Orcein**
Aydoğan Ş., İncekara Ü., Deniz A., TÜRÜT A.
MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.87, ss.2525-2530, 2010
- **Barrier height temperature coefficient in ideal Ti/n-GaAs Schottky contacts**
Göksu T., Yıldırım N., Korkut H., Özdemir A. F., TÜRÜT A., Kökçe A.
MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.87, ss.1781-1784, 2010
- **The theoretical and experimental study on double-Gaussian distribution in inhomogeneous barrier-height Schottky contacts**

Yıldırım N., TÜRÜT A., Türüt V.

MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.87, ss.2225-2229, 2010

- **Determination of contact parameters of Au/Carmine/n-Si Schottky device**

Aydoğan Ş., İncekara Ü., TÜRÜT A.

THIN SOLID FILMS, cilt.518, ss.7156-7160, 2010

- **Extraction of electronic parameters of Schottky diode based on an organic Indigotindisulfonate Sodium (IS)**

Aydoğan Ş., İncekara Ü., Deniz A., TÜRÜT A.

SOLID STATE COMMUNICATIONS, cilt.150, ss.1592-1596, 2010

- **n-type InP Schottky diodes with organic thin layer: Electrical and interfacial properties**

Güllü Ö., TÜRÜT A.

JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B, cilt.28, ss.466-472, 2010

- **Electrical properties of safranin T/p-Si organic/inorganic semiconductor devices**

Güllü Ö., Asubay S., Biber M., Kılıçoğlu T., TÜRÜT A.

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, cilt.50, 2010

- **Electronic properties of the metal/organic interlayer/inorganic semiconductor sandwich device**

Güllü Ö., Kılıçoğlu T., TÜRÜT A.

JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, cilt.71, ss.351-356, 2010

- **Electrical characterization of the Al/new fuchsin/n-Si organic-modified device**

Güllü Ö., Asubay S., Aydoğan Ş., TÜRÜT A.

PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES, cilt.42, ss.1411-1416, 2010

- **The frequency-dependent electrical characteristics of interfaces in the Sn/p-Si metal semiconductor structures**

Karataş Ş., TÜRÜT A.

MICROELECTRONICS RELIABILITY, cilt.50, ss.351-355, 2010

- **Influence of interface states on the temperature dependence and current-voltage characteristics of Ni/p-InP Schottky diodes**

Ejderha K., Yıldırım N., TÜRÜT A., Abay B.

SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES, cilt.47, ss.241-252, 2010

- **Current-Voltage Characteristics of Al/Rhodamine-101/n-GaAs Structures in the Wide Temperature Range**

Vural Ö., Şafak Y., Altındal Ş., TÜRÜT A.

Current Appl. Phys, cilt.10, 2010

- **Thermal annealing effects on I-V-T characteristics of sputtered Cr/n-GaAs diodes**

TÜRÜT A., Korkut H.

PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.404, ss.4039-4044, 2009

- **Electrical analysis of organic interlayer based metal/interlayer/semiconductor diode structures**

Güllü Ö., TÜRÜT A.

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, cilt.106, 2009

- **A theoretical analysis together with experimental data of inhomogeneous Schottky barrier diodes**

Yıldırım N., TÜRÜT A.

Microelectronic Engineering, cilt.86, 2009

- **DEPENDENCE OF CHARACTERISTIC DIODE PARAMETERS IN Ni/n-GaAs CONTACTS ON THERMAL ANNEALING AND SAMPLE TEMPERATURE**

Yıldırım N., Doğan H., Doğan H., TÜRÜT A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, cilt.23, ss.5237-5249, 2009

- **Electrical Properties of Organic-Inorganic Semiconductor Device Based on Rhodamine-101**

Çakar M., Güllü Ö., Yıldırım N., TÜRÜT A.

J. Electron. Mater., cilt.38, 2009

- **Temperature dependence of current-voltage characteristics in highly doped Ag/p-GaN/In Schottky diodes**

Çınar K., Yıldırım N., Coşkun C., TÜRÜT A.

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, cilt.106, 2009

- **Examination by interfacial layer and inhomogeneous barrier height model of temperature-dependent I-V**

characteristics in Co/p-InP contacts

Ejderha K., Yıldırım N., Abay B., TÜRÜT A.

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.484, ss.870-876, 2009

- **Determination of the laterally homogeneous barrier height of metal/p-InP Schottky barrier diodes**

Asubay S., Güllü Ö., TÜRÜT A.

VACUUM, cilt.83, ss.1470-1474, 2009

- **Electrical characterization of Au/n-ZnO Schottky contacts on n-Si**

Aydoğan Ş., Çınar K., Asil H., Coşkun C., TÜRÜT A.

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.476, ss.913-918, 2009

- **Series resistance determination of Au/Polypyrrole/p-Si/Al structure by current-voltage measurements at low temperatures**

Aydoğan Ş., Sağlam M., TÜRÜT A.

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-BIOMIMETIC AND SUPRAMOLECULAR SYSTEMS, cilt.29, ss.1486-1490, 2009

- **Temperature-dependent current-voltage characteristics of the Au/n-InP diodes with inhomogeneous Schottky barrier height**

Cimilli F., Sağlam M., Efeoğlu H., TÜRÜT A.

PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.404, ss.1558-1562, 2009

- **Fabrication and electrical characterization of a silicon Schottky device based on organic material**

Aydoğan Ş., Güllü Ö., TÜRÜT A.

PHYSICA SCRIPTA, cilt.79, 2009

- **Analysis of current-voltage-temperature characteristics and T-0 anomaly in Cr/n-GaAs Schottky diodes fabricated by magnetron sputtering technique**

Korkut H., Yıldırım N., TÜRÜT A., Doğan H.

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS, cilt.157, ss.48-52, 2009

- **Temperature-dependent current-voltage and capacitance-voltage characteristics of the Ag/n-InP/In Schottky diodes**

Cimilli F., Efeoğlu H., Sağlam M., TÜRÜT A.

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.20, ss.105-112, 2009

- **Irradiation effects on the C-V and G/w-V characteristics of Sn/p-Si (MS) structures**

Karataş Ş., TÜRÜT A., Altındal Ş.

Radiation Phys. and Chem, cilt.78, 2009

- **Temperature-dependent current-voltage characteristics of Cr/n-GaAs Schottky diodes**

Korkut H., Yıldırım N., TÜRÜT A.

MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.86, ss.111-116, 2009

- **Electrical characteristics and inhomogeneous barrier analysis of Au-Be/p-InSe: Cd Schottky barrier diodes**

Duman S., Gürbulak b., Doğan S., TÜRÜT A.

MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.86, ss.106-110, 2009

- **Temperature-dependent Schottky barrier inhomogeneity of Ni/n-GaAs diodes**

Yıldırım N., Korkut H., TÜRÜT A.

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, cilt.45, 2009

- **Reverse bias capacitance-voltage characteristics of Al/polyaniline/p-Si/Al structure as a function of temperature**

Aydoğan Ş., Sağlam M., TÜRÜT A.

JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, cilt.354, ss.4991-4995, 2008

- **DNA-based organic-on-inorganic devices: Barrier enhancement and temperature issues**

Güllü Ö., Çankaya M., Barış Ö., TÜRÜT A.

MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.85, ss.2250-2255, 2008

- **Effect of 6 MeV electron irradiation on electrical characteristics of the Au/n-Si/Al Schottky diode**

Uğurel E., Aydoğan Ş., Şerifoğlu K., TÜRÜT A.

MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.85, ss.2299-2303, 2008

- **Electrical characteristics and inhomogeneous barrier analysis of aniline green/p-Si heterojunctions**
Güllü Ö., Biber M., TÜRÜT A.
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.19, ss.986-991, 2008
- **Photovoltaic and electronic properties of quercetin/p-InP solar cells**
Güllü Ö., TÜRÜT A.
SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, cilt.92, ss.1205-1210, 2008
- **Effects of the barrier metal thickness and hydrogen pre-annealing on the characteristic parameters of Au/n-GaAs metal-semiconductor Schottky contacts**
Güllü Ö., Biber M., Van Meirhaeghe R. L. , TÜRÜT A.
THIN SOLID FILMS, cilt.516, ss.7851-7856, 2008
- **Fabrication and Electrical Characteristics of Al/PSP/n-Si/AuSb structure**
Güllü Ö., Aydoğan Ş., TÜRÜT A.
Vacuum, cilt.82, ss.1264-1268, 2008
- **Electron irradiation effects on the organic-on-inorganic silicon Schottky structure**
Güllü Ö., Aydoğan Ş., Şerifoğlu K., TÜRÜT A.
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT, cilt.593, ss.544-549, 2008
- **Gamma irradiation-induced changes at the electrical characteristics of organic-based Schottky structures**
Güllü Ö., Çankaya M., Biber M., TÜRÜT A.
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, cilt.41, 2008
- **Thermally Annealed Ni/n-GaAs(Si)/In Schottky Barrier Diodes. Microelectronic Engineer**
Doğan H., Yıldırım N., TÜRÜT A.
Microelectronic Engineering, cilt.85, 2008
- **Determination of lateral barrier height of identically prepared Ni/n-type Si Schottky barrier diodes by electrodeposition**
Güler G., Güllü Ö., Bakkaloğlu Ö. F. , TÜRÜT A.
PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.403, ss.2211-2214, 2008
- **Fabrication and electrical properties of Al/Safranin T/n-Si/AuSb structure**
Güllü Ö., Aydoğan Ş., TÜRÜT A.
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.23, 2008
- **Fabrication and electrical characteristics of Schottky diode based on organic material**
Güllü Ö., Aydoğan Ş., TÜRÜT A.
MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.85, ss.1647-1651, 2008
- **DNA-based organic-on-inorganic semiconductor Schottky structures**
Güllü Ö., Çankaya M., Barış Ö., Biber M., Özdemir H., Güllüce M., TÜRÜT A.
APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.254, ss.5175-5180, 2008
- **Fabrication and electrical properties of organic-on-inorganic Schottky devices**
Güllü Ö., Çankaya M., Biber M., TÜRÜT A.
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, cilt.20, 2008
- **DNA-modified indium phosphide Schottky device**
Güllü Ö., Çankaya M., Barış Ö., TÜRÜT A.
APPLIED PHYSICS LETTERS, cilt.92, 2008
- **The barrier-height inhomogeneity in identically prepared Ni/n-type 6H-SiC Schottky diodes**
Duman S., Doğan S., Gürbulak B., TÜRÜT A.
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, cilt.91, ss.337-340, 2008
- **Fabrication and electrical properties of Al/aniline green/n-Si/AuSb structure**
Aydoğan Ş., Güllü Ö., TÜRÜT A.
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.11, ss.53-58, 2008
- **Determination of the laterally homogeneous barrier height of thermally annealed and unannealed Au/p-InP/Zn-Au Schottky barrier diodes**
Asubay S., Güllü Ö., TÜRÜT A.
APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.254, ss.3558-3561, 2008

- **Laterally inhomogeneous barrier analysis of the methyl violet/p-Si organic/inorganic hybrid Schottky structures**
Güllü Ö., Barış Ö., Biber M., TÜRÜT A.
APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.254, ss.3039-3044, 2008
- **Temperature-dependent behavior of Ti/p-InP/ZnAu schottky barrier diodes**
Asubay S., Güllü Ö., Abay B., TÜRÜT A., Yılmaz A.
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.23, 2008
- **The effects of the temperature and annealing on current-voltage characteristics of Ni/n-type 6H-SiC Schottky diode**
Sefaoğlu A., Duman S., Doğan S., Gürbulak B., Tüzümen S., TÜRÜT A.
MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.85, ss.631-635, 2008
- **Electrical characterization of organic-on-inorganic semiconductor Schottky structures**
Güllü Ö., Asubay S., TÜRÜT A.
J. Phys.: Condens. Matter, cilt.20, 2008
- **Some electrical properties of polyaniline/p-Si/Al structure at 300 K and 77 K temperatures**
Aydoğan Ş., Sağlam M., TÜRÜT A.
Microelectronic Engineering, cilt.85, 2008
- **The electrical characteristics of Sn/methyl-red/p-type Si/Al contacts**
Aydın M. E. , TÜRÜT A.
MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.84, ss.2875-2882, 2007
- **Current-voltage characteristics of Al/Rhodamine-101/n-GaAs and Cu/Rhodamine-101/n-GaAs rectifier contacts**
Vural Ö., Yıldırım N., Altındal Ş., TÜRÜT A.
SYNTHETIC METALS, cilt.157, ss.679-683, 2007
- **Temperature-dependent behavior of Ni/4H-nSiC Schottky contacts**
Aydın M. E. , Yıldırım N., TÜRÜT A.
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, cilt.102, 2007
- **Prediction of lateral barrier height in identically prepared Ni/n-type GaAs Schottky barrier diodes**
Doğan H., Korkut H., Yıldırım N., TÜRÜT A.
APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.253, ss.7467-7470, 2007
- **Determination of the lateral barrier height of inhomogeneous Au/n-type InP/In Schottky barrier diodes**
Cimilli F., Sağlam M., TÜRÜT A.
Semiconductor Science and Technology, cilt.22, ss.851-854, 2007
- **Electrical characteristics of the hydrogen pre-annealed Au/n-GaAs Schottky barrier diodes as a function of temperature**
Güllü Ö., Biber M., Duman S., TÜRÜT A.
APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.253, ss.7246-7253, 2007
- **The electrical measurements in poly(2-chloroaniline) based thin film sandwich devices**
Özdemir A. F. , Gök A., TÜRÜT A.
THIN SOLID FILMS, cilt.515, ss.7253-7258, 2007
- **Electrical transport characteristics of Sn/p-Si schottky contacts revealed from I-V-T and C-V-T measurements**
Karataş Ş., Altındal Ş., TÜRÜT A., Çakar M.
PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.392, ss.43-50, 2007
- **Temperature-dependent optical absorption measurements and Schottky contact behavior in layered semiconductor n-type InSe(: Sn)**
Duman S., Gürbulak B., TÜRÜT A.
APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.253, ss.3899-3905, 2007
- **The conductance and capacitance-frequency characteristics of Au/pyronine-B/p-type Si/Al contacts**
Çakar M., Yıldırım N., Doğan H., TÜRÜT A.
APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.253, ss.3464-3468, 2007
- **Current-voltage and capacitance-voltage characteristics of Sn/rhodamine-101/n-Si and Sn/rhodamine-101/p-Si Schottky barrier diodes**

Çakar M., Yıldırım N., Karataş Ş., Temirci C., TÜRÜT A.

J. Appl. Phys, cilt.100, 2006

- **Electrical properties of Sn/p-Si (MS) Schottky barrier diodes to be exposed to (CO)-C-60 gamma-ray source**
Karataş Ş., TÜRÜT A.
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT, cilt.566, ss.584-589, 2006
- **Aging effects on the interface state density obtained from current-voltage and capacitance-frequency characteristics of polypyrrole/p-Si/Al structure**
Sağlam M., TÜRÜT A.
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.101, ss.2313-2319, 2006
- **Determination of the characteristic parameters of Sn/n-GaAs/Al-Ge Schottky diodes by a barrier height inhomogeneity model**
TÜRÜT A., Doğan H.
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.21, ss.822-828, 2006
- **Electrical properties of polypyrrole/p-InP structure**
Aydoğan Ş., Sağlam M., TÜRÜT A.
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS, cilt.44, ss.1572-1579, 2006
- **The determination of electronic and interface state density distributions of Au/n-type GaAs Schottky barrier diodes**
Karataş Ş., TÜRÜT A.
PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.381, ss.199-203, 2006
- **The temperature dependence of current-voltage characteristics of the Au/Polypyrrole/p-Si/Al heterojunctions**
Aydoğan Ş., Sağlam M., TÜRÜT A.
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, cilt.18, ss.2665-2676, 2006
- **The double Gaussian distribution of barrier heights in Au/n-GaAs Schottky diodes from I-V-T characteristics**
Özdemir A. F. , TÜRÜT A., Kökçe A.
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.21, ss.298-302, 2006
- **The effect of Schottky metal thickness on barrier height inhomogeneity in identically prepared Au/n-GaAs Schottky diodes**
Biber M., Güllü Ö., Forment S., Van Meirhaeghe R. L. , TÜRÜT A.
Semiconductor Science and Technology, cilt.21, ss.1-5, 2006
- **Temperature dependence of the current-voltage characteristics of the Al/Rhodamine-101/p-Si(1 0 0) contacts**
Karataş Ş., Temirci C., Çakar M., TÜRÜT A.
Applied Surface Science, cilt.252, 2006
- **Effects of Co-60 gamma-ray irradiation on the electrical characteristics of Au/n-GaAs (MS) structures**
Karataş Ş., TÜRÜT A., Altındal Ş.
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT, cilt.555, ss.260-265, 2005
- **On the some electrical properties of the non-ideal PPy/p-Si/Al structure**
Aydoğan Ş., Sağlam M., TÜRÜT A.
POLYMER, cilt.46, ss.10982-10988, 2005
- **Barrier height enhancement and stability of the Au/n-InP Schottky barrier diodes oxidized by absorbed water vapor**
Çetin H., Ayyıldız E., TÜRÜT A.
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B, cilt.23, ss.2436-2443, 2005
- **On the barrier inhomogeneities of polyaniline/p-Si/Al structure at low temperature**
Aydoğan Ş., Sağlam M., TÜRÜT A.
APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.250, ss.43-49, 2005
- **The dependence of I-V and C-V characteristics on temperature in the H-terminated Pb/p-Si(100) Schottky**

barrier diodes

Nuhođlu ., zerden E., TRT A.

APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.250, ss.203-208, 2005

- **Current-voltage-temperature analysis of inhomogeneous Au/n-GaAs Schottky contacts**

Biber M., Cořkun C., TRT A.

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, cilt.31, ss.79-86, 2005

- **Characterization of capacitance-frequency features of Sn/polypyrrole/n-Si structure as a function of temperature**

Aydođan ř., Sađlam M., TRT A.

POLYMER, cilt.46, ss.6148-6153, 2005

- **Ti/p-Si Schottky barrier diodes with interfacial layer prepared by thermal oxidation**

etin H., řahin B., Ayyıldız E., TRT A.

PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.364, ss.133-141, 2005

- **The effects of the temperature on current-voltage characteristics of Sn/polypyrrole/n-Si structures**

Aydođan ř., Sađlam M., TRT A., Onganer Y.

SYNTHETIC METALS, cilt.150, ss.15-20, 2005

- **Current-voltage and capacitance-voltage characteristics of polypyrrole/p-InP structure**

Aydođan ř., Sađlam M., TRT A.

VACUUM, cilt.77, ss.269-274, 2005

- **The effects of the temperature on the some parameters obtained from current-voltage and capacitance-voltage characteristics of polypyrrole/n-Si structure**

Aydođan ř., Sađlam M., TRT A.

POLYMER, cilt.46, ss.563-568, 2005

- **The effect of series resistance on the relationship between barrier heights and ideality factors of inhomogeneous Schottky barrier diodes**

Akkılı K., Aydın M. E. , TRT A.

PHYSICA SCRIPTA, cilt.70, ss.364-367, 2004

- **Influence of hydrogen treatment and annealing processes upon the Schottky barrier height of Au/n-GaAs and Ti/n-GaAs diodes**

Forment S., Biber M., Van Meirhaeghe R. L. , Leroy W. P. , TRT A.

SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.19, ss.1391-1396, 2004

- **Low- and high-frequency C-V characteristics of the contacts formed by sublimation of the nonpolymeric organic compound on p-type Si substrate**

Temirci C., akar M., TRT A., Onganer Y.

PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE, cilt.201, ss.3077-3086, 2004

- **The effects of the time-dependent on the characteristic parameters of polypyrrole/p-type Si/Al diode**

TRT A., Sađlam M., Korucu D.

POLYMER, cilt.45, ss.7335-7340, 2004

- **The barrier-height inhomogeneity in identically prepared H-terminated Ti/p-Si Schottky barrier diodes**

etin H., řahin B., Ayyıldız E., TRT A.

SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.19, ss.1113-1116, 2004

- **The effects of the ageing on the characteristic parameters of polyaniline/p-type Si/Al structure**

Sađlam M., Korucu D., TRT A.

APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.230, ss.404-410, 2004

- **The determination of interface state energy distribution of the H-terminated Zn/p-type Si Schottky diodes with high series resistance by the admittance spectroscopy**

Karatař ř., TRT A.

VACUUM, cilt.74, ss.45-53, 2004

- **Experimental determination of the laterally homogeneous barrier height of Au/n-Si Schottky barrier diodes**

Sađlam M., Cimilli C., TRT A.

PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.348, ss.397-403, 2004

- **The schottky barrier height of the rectifying Cu/, au/, Sn/ and Al/pyronine-B/p-Si contacts**

Çakar M., Temirci C., TÜRÜT A.

SYNTHETIC METALS, cilt.142, ss.177-180, 2004

- **Rectifying pyronine-B/p-type silicon junctions formed by sublimation of pyronine-B**

Çakar M., TÜRÜT A., Onganer Y.

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.15, ss.47-53, 2004

- **Linear correlation between barrier heights and ideality factors of Sn/n-Si schottky diodes with and without the interfacial native oxide layer**

Akkiliç K., Kılıçoğlu T., TÜRÜT A.

PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.337, ss.388-393, 2003

- **Temperature dependence of characteristic parameters of the H-terminated Sn/p-Si(100) Schottky contacts**

Karataş Ş., Altındal Ş., TÜRÜT A., Özmen A.

APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.217, ss.250-260, 2003

- **The conductance and capacitance-frequency characteristics of the organic compound (pyronine-B)/p-Si structures**

Çakar M., TÜRÜT A.

SYNTHETIC METALS, cilt.138, ss.549-554, 2003

- **Effect of hydrostatic pressure on characteristics parameters of Sn/p-Si Schottky diodes**

Çakar M., Temirci C., TÜRÜT A., Çankaya G.

PHYSICA SCRIPTA, cilt.68, ss.70-73, 2003

- **The conductance and capacitance-frequency characteristics of polypyrrole/p-type Si structures**

Çakar M., Biber M., Sağlam M., TÜRÜT A.

J. Polymer Sci. B: Polymer Phys, cilt.41, 2003

- **The barrier height inhomogeneity in identically prepared Pb/p-type Si Schottky barrier diodes**

Nuhoğlu Ç., Aydoğan Ş., TÜRÜT A.

Semiconductor Science and Technology, cilt.18, 2003

- **Correlation between barrier heights and ideality factors of Cd/n-Si and Cd/p-Si Schottky barrier diodes**

Akkiliç K., TÜRÜT A., Çankaya G., Kılıçoğlu T.

SOLID STATE COMMUNICATIONS, cilt.125, ss.551-556, 2003

- **The energy distribution of the interface state density of Pb/p-Si Schottky contacts exposed to clean room air**

Çetinkara H., TÜRÜT A., Zengin D., Erel Ş.

APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.207, ss.190-199, 2003

- **The interface state energy distribution from capacitance-frequency characteristics of gold/n-type Gallium arsenide Schottky barrier diodes exposed to air**

Özdemir A. F. , TÜRÜT A., Kökçe A., Özdemir A. F.

THIN SOLID FILMS, cilt.425, ss.210-215, 2003

- **The Cu/n-GaAs Schottky barrier diodes prepared by anodization process**

Biber M., TÜRÜT A.

JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, cilt.31, ss.1362-1368, 2002

- **The conductance- and capacitance-frequency characteristics of the rectifying junctions formed by sublimation of organic pyronine-B on p-type silicon**

TÜRÜT A., Onganer Y., Çakar M.

JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, cilt.168, ss.169-174, 2002

- **Determination of the density distribution of interface states from high- and low-frequency capacitance characteristics of the tin/organic pyronine-B/p-type silicon structure**

Çakar M., Temirci C., TÜRÜT A.

CHEMPHYSICHEM, cilt.3, ss.701-0, 2002

- **The effects of the time-dependent and exposure time to air on Au/n-GaAs schottky barrier diodes**

Özdemir A. F. , Kökçe A., TÜRÜT A.

APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.191, ss.188-195, 2002

- **The nonpolymeric organic compound (pyronine-B)/p-type silicon/Sn contact barrier devices**

Çakar M., Onganer Y., TÜRÜT A.

SYNTHETIC METALS, cilt.126, ss.213-218, 2002

- **The determination of the interface-state density distribution from the capacitance-frequency measurements in Au/N-Si Schottky barrier diodes**
Ayyıldız E., Lu C., TÜRÜT A.
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, cilt.31, ss.119-123, 2002
- **Barrier height enhancement in the Au/n-GaAs Schottky diodes with anodization process**
Biber M., Temirci C., TÜRÜT A.
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B, cilt.20, ss.10-13, 2002
- **Temperature dependent barrier characteristics of CrNiCo alloy Schottky contacts on n-type molecular-beam epitaxy GaAs**
Gümüş A., TÜRÜT A., Yalçın N.
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, cilt.91, ss.245-250, 2002
- **The effect of anodic oxide treatment on n-GaAs Schottky barrier diodes**
Biber M., Çakar M., TÜRÜT A.
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.12, ss.575-579, 2001
- **The effect of series resistance on calculation of the interface state density distribution in Schottky diodes**
Temirci C., Ayyıldız E., Batı B., TÜRÜT A.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, cilt.88, ss.625-633, 2001
- **High-barrier height Sn/p-Si Schottky diodes with interfacial layer by anodization process**
Temirci C., Batı B., Sağlam M., TÜRÜT A.
APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.172, ss.1-7, 2001
- **Reverse bias capacitance-voltage characteristics of Au/n-GaAs Schottky diodes under hydrostatic pressure**
Çankaya G., Uçar N., TÜRÜT A.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, cilt.87, ss.1171-1176, 2000
- **An investigation of I-V characteristics of Au/n-GaAs Schottky diodes after hydrostatic pressure**
Çankaya G., Uçar N., TÜRÜT A.
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH, cilt.179, ss.469-473, 2000
- **Current-voltage and capacitance-voltage characteristics of metallic polymer/InSe(Er) Schottky contacts**
Abay B., Onganer Y., Sağlam M., Efeoğlu H., TÜRÜT A., Yoğurtçu Y. K.
MICROELECTRONIC ENGINEERING, ss.689-693, 2000
- **On the forward bias excess capacitance at intimate and MIS Schottky barrier diodes with perfect or imperfect ohmic back contact**
Batı B., Nuhoğlu Ç., Sağlam M., Ayyıldız E., TÜRÜT A.
PHYSICA SCRIPTA, cilt.61, ss.209-212, 2000
- **Effect of thermal annealing on Co/n-LEC GaAs (Te) Schottky contacts**
Nuhoğlu Ç., Temirci C., Biber M., TÜRÜT A.
SOLID STATE COMMUNICATIONS, cilt.115, ss.291-295, 2000
- **Effect of hydrostatic pressure on the characteristic parameters of Au/n-GaAs Schottky-barrier diodes**
Çankaya G., Uçar N., Efeoğlu H., TÜRÜT A., Tüzümen S., Yoğurtçu Y. K.
PHYSICAL REVIEW B, cilt.60, ss.15944-15947, 1999
- **Dependence of thermal annealing on the density distribution of interface states in Ti/n-GaAs(Te) Schottky diodes**
Ayyıldız E., Batı B., Temirci C., TÜRÜT A.
APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.152, ss.57-62, 1999
- **The effect of thermal treatment on the characteristic parameters of Ni/-, Ti/- and NiTi alloy n-GaAs Schottky diodes**
Ayyıldız E., TÜRÜT A.
SOLID-STATE ELECTRONICS, cilt.43, ss.521-527, 1999
- **The effect of the time-dependent and expose time to air on Au/Epilayer n-Si Schottky Diodes**
Çetinkara H., Sağlam M., TÜRÜT A., Yalçın N.
The European Physical Journal Applied Physics, cilt.6, 1999
- **Thermal stability of NiTi alloy contacts on n-type liquid encapsulated Czochralski GaAs**

Ayyıldız E., TÜRÜT A., Tüzümen S.

SOLID STATE COMMUNICATIONS, cilt.110, ss.419-423, 1999

- **Cr/- and Fe/n-GaAs Schottky diodes: the stable current-voltage characteristic produced by high-temperature annealing**
Nuhoğlu Ç., Sağlam M., TÜRÜT A.
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.14, ss.114-117, 1999
- **Thermal treatment of the MIS and intimate Ni/n-LEC GaAs Schottky barrier diodes**
Nuhoğlu Ç., Ayyıldız E., Sağlam M., TÜRÜT A.
APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.135, ss.350-356, 1998
- **Thermal stability of Cr-Ni-Co alloy Schottky contacts on MBE n-GaAs**
TÜRÜT A., Gümüş A., Sağlam M., Tüzümen S., Efeoğlu H.
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.13, ss.776-780, 1998
- **The effect of thermal annealing on series resistance of Nwarily ideal and ideal Ti/n-GaAs Schottky diodes**
Ayyıldız E., Sağlam M., Nuhoğlu Ç., TÜRÜT A.
Physica Scripta, cilt.58, 1998
- **Effect of thermal annealing in nitrogen on the I-V and C-V characteristics of Cr-Ni-Co alloy/LEC n-GaAs Schottky diodes**
Saglam M., Turut A.
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.12, ss.1028-1031, 1997
- **Characteristics of metallic polymer and Au Schottky contacts on cleaved surfaces of InSe(:Er)**
Abay B., Onganer Y., Sağlam M., Efeoğlu H., TÜRÜT A., Yoğurtçu Y. K.
SOLID-STATE ELECTRONICS, cilt.41, ss.924-926, 1997
- **, Influence of thermal annealing, the lectrolyte pH, and current density on the interface state density distribution of anodic MOS structures**
Sağlam M., TÜRÜT A., Nuhoğlu Ç., Efeoğlu H., Kılıçoğlu T., Ebeoğlu M. A.
Applied Physics A, cilt.65, 1997
- **The series resistance calculation at MIS Schottky barrier diodes**
Sağlam M., Ayyıldız E., Gümüş A., TÜRÜT A., Efeoğlu H., Tüzümen S.
Applied Physics A, cilt.62, 1996
- **High barrier metallic polymer p-type silicon Schottky diodes**
Onganer Y., Sağlam M., TÜRÜT A., Efeoğlu H., Tüzümen S.
SOLID-STATE ELECTRONICS, cilt.39, ss.677-680, 1996
- **The bias-dependence change of barrier height of Schottky diodes under forward bias by including the series resistance effect**
TÜRÜT A., Batı B., Kökçe A., Sağlam M., Yalçın N.
PHYSICA SCRIPTA, cilt.53, ss.118-122, 1996
- **Effect of series resistance on the forward current-voltage characteristics of Schottky diodes in the presence of interfacial layer**
Ayyıldız E., TÜRÜT A., Efeoğlu H., Tüzümen S., Sağlam M., Yoğurtçu Y. K.
SOLID-STATE ELECTRONICS, cilt.39, ss.83-87, 1996
- **EFFECTS OF ELECTROLYTE PH ON ELECTRICAL-PROPERTIES OF THE INTERFACE BETWEEN N-INSB AND ITS ANODIC NATIVE-OXIDE**
Kılıçoğlu T., Öztürk Z., Ebeoğlu M. A. , TÜRÜT A., özdemir M., Altındal A.
INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS, cilt.33, ss.205-209, 1995
- **INTERPRETING THE NONIDEAL REVERSE BIAS C-V CHARACTERISTICS AND IMPORTANCE OF THE DEPENDENCE OF SCHOTTKY-BARRIER HEIGHT ON APPLIED VOLTAGE**
TÜRÜT A., Sağlam M., Efeoğlu H., Yalçın N., Yıldırım M., Abay B.
PHYSICA B, cilt.205, ss.41-50, 1995
- **Polyindole-based Schottky diode**
Köleli F., Sağlam M., TÜRÜT A., Efeoğlu H.
Tr. J. of Chemistry, cilt.18, 1994
- **METALLIC POLYTHIOPHENE INORGANIC SEMICONDUCTOR SCHOTTKY DIODES**
TÜRÜT A., Köleli F.

PHYSICA B, cilt.192, ss.279-283, 1993

- **BARRIER HEIGHT ENHANCEMENT BY ANNEALING CR-NI-CO ALLOY SCHOTTKY CONTACTS ON LEC GAAS**

TÜRÜT A., TUZEMEN S., Yıldırım M., Abay B., Sağlam M.

SOLID-STATE ELECTRONICS, cilt.35, ss.1423-1426, 1992

- **DETERMINATION OF THE DENSITY OF SI-METAL INTERFACE STATES AND EXCESS CAPACITANCE CAUSED BY THEM**

TÜRÜT A., Sağlam M.

PHYSICA B, cilt.179, ss.285-294, 1992

- **SEMICONDUCTIVE POLYMER-BASED SCHOTTKY DIODE**

TÜRÜT A., Köleli F.

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, cilt.72, ss.818-819, 1992

- **PARAMETER EXTRACTION FROM NONIDEAL C-V CHARACTERISTICS OF A SCHOTTKY DIODE WITH AND WITHOUT INTERFACIAL LAYER**

TÜRÜT A., YALCIN N., SAGLAM M.

SOLID-STATE ELECTRONICS, cilt.35, ss.835-841, 1992

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- **Electrical characteristics of Au/Ti/HfO₂/n-GaAs metal-insulator-semiconductor structures with high-k interfacial layer**

Karabulut A., orak İ., TÜRÜT A.

International Journal of Chemistry and Technology, cilt.2, no.2, ss.116-122, 2018

- **Influence of Al₂O₃ barrier on the interfacial electronic structure of Au/Ti/n-GaAs structures**

Karabulut A., EFEOĞLU H., TÜRÜT A.

JOURNAL OF SEMICONDUCTORS, cilt.38, 2017

- **Characteristic diode parameters in thermally annealed Ni/p-InP contacts**

TÜRÜT A., Ejderha K., Yıldırım N., ABAY B.

JOURNAL OF SEMICONDUCTORS, cilt.37, 2016

- **Determination of barrier height temperature coefficient by Norde's method in ideal Co/n-GaAs Schottky contacts**

TÜRÜT A.

TURKISH JOURNAL OF PHYSICS, cilt.36, ss.235-244, 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

- **Nuclear Science and Technology**

TÜRÜT A., Korkut H., Doğan H., Korkut T.

Estimation of neutron irradiation damages in Ni/n-GaAs Schottky contact layers via FLUKA Monte Carlo simulations, Korkut T., Editör, Transworld Research Network, Kerala, ss.51-58, 2012

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

- **; A Study on The Effect of Doping Ir to LaCrO₃ Perovskites In Terms of All Electrical and Dielectric Properties Through The Impedance Spectroscopy**

COŞKUN F. M. , COŞKUN M., polat ö., TÜRÜT A.

2 rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SEMICONDUCTOR MATERIALS AND DEVICES, Ardahan, Türkiye, 28 Ağustos 2018

- **Wide Range Frequency and Temperature Dependent Electrical Property Study of LaCrO₃ And Cobalt (Co) Doped LaCrO₃ Perovskite Compounds**

COŞKUN F. M. , COŞKUN M., polat ö., TÜRÜT A.

2 rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SEMICONDUCTOR MATERIALS AND DEVICES, Ardahan, Türkiye, 28 Ağustos 2018

- **Current Voltage and Capacitance Voltage Characteristics of Sputtered Ni/n-GaAs Schottky diodes**
TÜRÜT A., Yıldırım N.
International Congress on Semiconductor Materials and Devices” (ICSMD-2017), Konya, Türkiye, 17 Ağustos 2017, ss.17
- **The electrical and dielectric properties of Au/Ti/HfO₂/n-GaAs structures in wide temperature range**
TÜRÜT A., KARABULUT A., Karataş Ş.
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY FOR NEXT GENERATION (MSNG2017), Sarajevo/Bosnia, Bosna-Hersek, 28 Haziran 2017, ss.320-323
- **Some Electrical Characteristics Of GaAs–Based MIS Structures With Atomic Layer Deposited Thin HfO₂ Interfacial Layer**
TÜRÜT A., KARABULUT A.
NANOSCIENCE&NANOTECHNOLOGY FOR NEXT GENERATION-NanoNG-2016, Antalya, Türkiye, 20 Ekim 2016, ss.83
- **Ni/n-GaN Schottky diyotların Ellektriksel Karakteristikleri Üzerine Numune Sıcaklığının ve Isıl Tavlamanın Etkileri (Effect of thermal annealing and sample temperature on electrical characteristics of Ni/n-GaN Schottky contacts)**
TÜRÜT A., Yıldırım N., Ejderha K.
IPCAP 2016 – INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCE AT THE ANATOLIAN PEAK, Erzurum, Türkiye, 25 Şubat 2016, ss.160
- **Characteristic diode parameters of thermally annealed Ni/n-GaAs Schottky contacts over a wide measurement temperature range**
TÜRÜT A., Doğan H., YILDIRIM N.
International Physics Conference at the Anatolian Peak, IPCAP 2016, Erzurum, Türkiye, 25 Şubat 2016, ss.57
- **Atomic Layer Deposited Ultra Thin HfO₂ Interfacial Layer Grown on GaAs-based MIS Structure in 60-400 K Temperature Range**
TÜRÜT A., KARABULUT A., BİYKLI N.
International Conference On Nanoscience and Nanotechnology For Next Generation-Nanong, Antalya, Türkiye, 29 Ekim 2015
- **Electrical Parameters of Safranine T/n-Si Contacts**
GÜLLÜ O., ARSEL I., ÖZKAN S., ÖZAYDIN C., PAKMA O., TÜRÜT A.
9 th International Physics Conference of The Balcan Physical Union BPU-9, İstanbul, Türkiye, 24 Ağustos 2015
- **I-V and C-V-f Characteristics of Aniline Green/n-Type Silicon Diode**
ÖZKAN S., GÜLLÜ O., ARSEL I., ÖZAYDIN C., PAKMA O., TÜRÜT A.
9 th International Physics Conference of The Balcan Physical Union BPU-9, İstanbul, Türkiye, 24 Ağustos 2015
- **The Electrical Characteristics of the Al/Congo Red (CR)/p-Si Semiconductor Diodes**
GÜLLÜ O., PAKMA O., ARSEL I., TÜRÜT A.
ADIM Günleri-IV, Kütahya, Türkiye, 28 Mayıs 2015
- **I-V Characteristics of The Orange G/p-Type Silicon Cotacts**
GÜLLÜ O., ARSEL I., PAKMA O., ÖZAYDIN C., TÜRÜT A.
ADIM Günleri-IV, Kütahya, Türkiye, 28 Mayıs 2015
- **Current-Capacitance-Voltage Characteristics for the Au/Ti/Al₂O₃/n-GaAs Structure in 20-300 K range**
TÜRÜT A., KARABULUT A., EFEOĞLU H., BİYKLI N.
International Semiconductor Science and Techology Conference-ISSTC, İzmir, Türkiye, 11 Mayıs 2015
- **The Effect of Sol Concentration on The Structural and Electrical Parameters of Nanostructure ZnO Films by Sol Gel Dip Coating**
İLGÜ G., ÇAĞLAR Y., İLİCAN S., ÇAĞLAR M., RÜZGAR Ş., TÜRÜT A.
NanoNG-14 International Conference, Elazığ, Türkiye, 20 Ağustos 2015
- **Illumination Impact On The Electrical Characteristics of Sputtered Au/Ti/ Al₂O₃/N-GaAs Schottky Diodes With Atomic Layer Deposited Al₂O₃ Interfacial Layer**
Karabulut A., Ejderha K., Haider A., Biyıklı N., TÜRÜT A.
International Semiconductor Science and Technology Conference-2014, Türkiye, 01 Ocak 2014, ss.139

- **Homogenous Barrier Height Work on Ni/EPI-n-Si structure**
Ejderha K., Karabulut A., TÜRÜT A.
International Semiconductor Science and Technology Conference-2014, Türkiye, 01 Ocak 2014, ss.60
- **Effects Of The Radiation On Al/Organic Film/P-Silicon Semiconductor Diode**
Güllü Ö., Asubay S., Kılıçoğlu T., Biber M., TÜRÜT A.
International Semiconductor Science and Technology Conference-2014, Türkiye, 01 Ocak 2014, ss.115
- **The Electrical and Photovoltaic Effect of Co/n-GaP Schottky Diode**
Orak İ., Ejderha K., Yıldırım ., Karabulut A., TÜRÜT A.
International Semiconductor Science and Technology Conference-2014, Türkiye, 01 Ocak 2014, ss.72
- **Electrical properties of I-V and C-V Characteristics of The Au/n-GaAs Schottky Diodes at High Temperatures**
Karteri İ., Özerli H., Karataş Ş., Bakkaloğlu Ö. F. , TÜRÜT A.
International Semiconductor Science and Technology Conference-2014, Türkiye, 01 Ocak 2014, ss.68
- **Metal-Thickness Dependence On The Electrical Properties of Ideal Ti/n-GaAs Schottky Contacts**
Göksu T., Özdemir A. F. , Uçar N., TÜRÜT A.
International Semiconductor Science and Technology Conference-2014, Türkiye, 01 Ocak 2014, ss.123
- **Capacitance–Voltage Characteristics Of Ni/Au/n-GaN Contacts**
Orak İ., Doğan H., Ejderha K., Yıldırım ., TÜRÜT A.
International Semiconductor Science and Technology Conference-2014, Türkiye, 01 Ocak 2014, ss.113
- **The comparison of electrical properties of Au/graphene/p-Si and graphene/p-Si**
Orak İ., Ejderha K., Yıldırım N., TÜRÜT A.
BSW2013 Fourth Science Workshop: Studies on Structure and Dynamics from Nucleus to Clusters, Yozgat,, Yozgat, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.12
- **Investigation of photovoltaic property for sputtered Al/p-Si/Al structure**
Ejderha K., Yıldırım N., Orak İ., TÜRÜT A.
BSW2013 Fourth Science Workshop: Studies on Structure and Dynamics from Nucleus to Clusters, Yozgat,, Yozgat, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.11-12
- **Investigation of electrical properties CrTi/n-GaN nano structure**
TÜRÜT A., Orak İ., Ejderha K., Yıldırım N.
BSW2013 Fourth Science Workshop: Studies on Structure and Dynamics from Nucleus to Clusters, Yozgat,, Yozgat, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.13
- **A Molecular Dynamic Approach to the Aggregation of Amyloid A β (17-21) Peptides**
TÜRÜT A., Kılınç T., Tekin E.
10. Kimyasal Fizik Kongresi (CPC-X), Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2012, ss.90
- **The evaluation of temperature dependent I-V and C-V characteristics on Au/p-InP Schottky Barrier Diode prepared by photolithography technique**
TÜRÜT A., Korucu D.
29th International congress, Türkiye, 01 Eylül 2012
- **e-beam litografi ile III-V grubu yarıiletken üzerine metal nano-lontakların oluşturulması**
TÜRÜT A., orak i., Ejderha K., Yıldırım N., Ürer M.
29. TFD-Uluslararası FİZİK Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Eylül 2012
- **Molecular Dynamics Simulations of A β (16-22) Peptides Aggregation**
TÜRÜT A., Kılınç T., Tekin E.
8. Nanoscience&Nanotechnology Congress, Ankara, Türkiye, 01 Haziran 2012, ss.734-207
- **Characterization Of Au/N-Inp Photovoltaic Structure With Organic Thin Film**
TÜRÜT A., Güllü Ö., Özerden E., Rüzgar Ş., Asubay S., Pakma O., Kılıçoğlu T.
4th Hybrid and Organic Photovoltaics Conference, İsveç, 01 Mayıs 2012
- **Some Considerable Effects on Pt/n-InP Schottky Diode Current-Voltage Characteristics due to Electron Irradiation**
TÜRÜT A., Korkut H.
on advances in Applied Physics and Material Science (201) American Institute of Physics, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Aralık 2011, cilt.1400, no.1, ss.497-501
- **Current-Voltage, Capacitance-Voltage-Frequency And Interface Characteristics Of Metal/Organic Dye**

Molecule/P-Type Inp Photovoltaic Device

TÜRÜT A., Güllü Ö., Özerden E., Kılıçoğlu T.

2. Semiconductor Sensitized Solar Cell Conference, İspanya, 01 Eylül 2011

• **Control of barrier height of metal/semiconductor contacts by molecular organic film**

TÜRÜT A., Güllü Ö., Özerden E., Kılıçoğlu T.

7. International Conference on Organic Electronics, İtalya, 01 Haziran 2011

• **Analysis of I-V Characteristics of Au/n-type GaAs Schottky diodes**

Karataş Ş., TÜRÜT A., Altındal Ş.

Türk Fizik Derneği 23. Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 01 Eylül 2005, ss.628

• **Aynı şartlar altında hazırlanmış Au/n-Si/Au-Sb MIS Schottky diyotlarının C-V ölçümlerinden elde edilen engel yükseklikleri ve taşıyıcı konsantrasyonları**

Cimilli F., Sağlam M., Aydoğan Ş., TÜRÜT A.

Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, Erzurum, Türkiye, 01 Mayıs 2005

• **Au/n-Si/Au-Sb Schottky diyodunun akım-voltaj ve kapasite-voltaj karakteristiklerinin sıcaklığa bağlı değişimi**

Cimilli F., Sağlam M., Aydoğan Ş., TÜRÜT A.

Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, Erzurum, Türkiye, 01 Mayıs 2005

• **Aynı şartlar altında hazırlanmış Au/n-Si/Au-Sb MIS Schottky diyotlarının idealite faktörleri ile engel yükseklikleri arasındaki ilişki**

Cimilli F., Sağlam M., Aydoğan Ş., TÜRÜT A.

Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, Erzurum, Türkiye, 01 Mayıs 2005

• **Polipirol/p-InP yapının bazı karakteristik parametrelerinin akım-voltaj, kapasite-voltaj ve kapasite-frekans ölçümlerinden elde edilmesi**

Aydoğan Ş., Sağlam M., TÜRÜT A.

Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, Erzurum, Türkiye, 01 Mayıs 2005

• **Au/polianilin/p-Si yapının doğrultma özelliğinin incelenmesi**

Aydoğan Ş., Sağlam M., TÜRÜT A.

Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 01 Eylül 2004

• **Effect of Series Resistance and Insulator Layer on the Current-Voltage Characteristics in Au/n-GaAs Schottky Diodes**

Karataş Ş., Altındal Ş., TÜRÜT A.

Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 01 Eylül 2004, ss.455

• **Polipirol/p-Si ve Polipirol/n-Si yapıların bazı karakteristik parametrelerinin akım-voltaj ve kapasite-voltaj ölçümlerinden elde edilmesi**

Aydoğan Ş., Sağlam M., TÜRÜT A.

Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 01 Eylül 2004

• **Polipirol/p-Si/Al diyodunun karakteristik parametrelerinin zamana bağlılığı**

Korucu D., Sağlam M., TÜRÜT A.

Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 01 Eylül 2004

• **Polipirol/p-Si/Al diyodunun parametrelerinin artan yaşlanma zamanıyla değişimi**

Korucu D., Sağlam M., TÜRÜT A.

Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 01 Eylül 2004

• **Sıcaklığın Bir Fonksiyonu olarak Zn/p-Si Schottky Diyot Karakteristiklerinin İncelenmesi**

Karataş Ş., Altındal Ş., Çakar M., TÜRÜT A.

10. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara, Türkiye, 01 Kasım 2003, ss.16

• **Au/n-GaAs Schottky Diyotlarda Arayüzey Durum Yoğunluklarının Yasak Enerji Aralığındaki Dağılım profilinin Akım-Voltaj (I-V) Karakteristiklerinden Elde Edilmesi**

Karataş Ş., Altındal Ş., TÜRÜT A., Özmen A., Çakar M.

Turkish Physical Society 21th Physics Conference, Isparta, Türkiye, 01 Eylül 2002, ss.379

• **İdeal Olmayan Schottky Diyotlarının Temel Parametrelerinin I-V Karakteristiklerinden Hesaplanması**

Altındal Ş., Karataş Ş., TÜRÜT A., Çakar M., Özmen A.

Turkish Physical Society 21th Physics Conference, Isparta, Türkiye, 01 Eylül 2002, ss.280

• **A comparative study of interface state density in anodic and thermal MOS structures**

Sağlam M., TÜRÜT A.

Hellenic Physical Society & Turkish Physical Society, First Hellenic-Turkish International Physics Conference, Türkiye, 01 Eylül 2001

- **The Investigating of the Ageing Effect on Au/-, Cu/n-GaAs Schottky Diodes Having Different Barrier Height With Anodic Oxidation**

Biber M., TÜRÜT A.

Balkan Physics Letters, Türkiye, 01 Eylül 2001

- **Au/n-Si Schottky diyotlarda omik kontak direncinin kapasite-frekans (C-f) karakteristiklerine etkisi**

Batı B., Temirci C., Sağlam M., TÜRÜT A.

TFD 19. Fizik Kongresi, Elazığ, Türkiye, 01 Eylül 2000

- **Au/n-Si Schottky diyotların Kapasite-frekans Karakteristiklerinden Arayüzey Hal Dağılım Eğrilerinin Belirlenmesi**

Ayyıldız E., Sağlam M., Nuhoğlu Ç., Temirci C., Biber M., TÜRÜT A., Yalçın N.

YMF 2000, TFD II. Ulusal Yoğun Madde Fiziği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 01 Haziran 2000

- **Au/n-Si Metal-Yarıiletken Kontaklarında Arayüzey Hallerinin Dağılım Eğrilerinin ve Bazı Diyot Parametrelerinin Belirlenmesi**

Ayyıldız E., Sağlam M., Nuhoğlu Ç., Temirci C., Biber M., TÜRÜT A.

TFD-18 Ulusal Fizik Kongresi, Adana, Türkiye, 01 Ekim 1999

- **Epitaksiyel silisyum'dan yapılan Au/n-Si Schottky diyotlarına havaya maruz bırakılma süresinin etkileri**

Çetinkara H., Sağlam M., TÜRÜT A., Yalçın N.

TFD-17 Ulusal Fizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 1998

- **Düşük Sıcaklıklarda MBE CrNiCo/n-GaAs Schottky Diyotlarında I-V Karakteristiklerinin Analizi**

Gümüş A., Sağlam M., Tüzemen S., Efeoğlu H., TÜRÜT A., Yalçın N.

TFD-17 Ulusal Fizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 1998

- **Epitaksiyel olarak büyütülmüş n-Si ile yapılan Au / n-Si Schottky diyotların karakteristik parametrelerinin belirlenmesi**

Çetinkara H., Sağlam M., Ayyıldız E., Nuhoğlu Ç., TÜRÜT A., Yalçın N.

16 Ulusal Fizik Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 01 Ağustos 1996

- **Al / Anodik SiO₂ / p-Si MOS yapılarında arayüzey hal yoğunluk dağılımı üzerine termal tavlama ve anodik oksidasyon parametrelerinin etkisi**

Sağlam M., TÜRÜT A., Efeoğlu H., Yıldırım M., Yoğurtçu Y.

TFD-15 Ulusal Fizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 1995

- **LEC tekniğiyle büyütülmüş GaAs 'ın kuantum veriminin lazer yardımıyla anodik oksidasyon ile artırılması**

Efeoğlu H., Tüzemen S., Sağlam M., TÜRÜT A., Abay B., Yıldırım M., Gürbulak B., Coşkun C., Yoğurtçu Y.

TFD-15 Ulusal Fizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 1995

- **Tam otomatik Fotolüminesans sisteminin dizaynı ve yarıiletken karakterizasyonunda uygulanması**

Efeoğlu H., Tüzemen S., Yıldırım M., Abay B., TÜRÜT A., Sağlam M., Gürbulak B., Yoğurtçu Y.

TFD-15 Ulusal Fizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 1995

- **Seri dirençli Cu/p-Si Schottky diyodunda bazı parametrelerin tayini**

Gümüş A., Yalçın N., TÜRÜT A., Sağlam M., Dartıcı A.

TFD-13 Ulusal Fizik Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 1992

- **p-Si kristalinden yapılan simetrik yapıların I(V) ve C(V) karakteristiklerinden bazı parametrelerin hesaplanması**

Dartıcı A., Gümüş A., Yalçın N., TÜRÜT A., Sağlam M.

TFD-13 Ulusal Fizik Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Ekim 1992

Desteklenen Projeler

TÜRÜT A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ni/n-GaN Schottky diyotlarının Elektriksel Karakteristikleri Üzerine Numune Sıcaklığının ve Isıl Tavlamanın Etkileri (Effect of thermal annealing and sample temperature on electrical characteristics of Ni/n-GaN Schottky contacts), 2016 - 2016

TÜRÜT A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Atomik Layer Depozasyon ALD metoduyla hazırlanan Au/Ti/HfO₂/n-GaAs Yapıların 60-400 K sıcaklık aralığında Akım-gerilim karakteristikleri, 2015 - 2016

TÜRÜT A., AKDENİZ DURAN E., ÖZKAN M. A. , SÖĞÜT S., OKTAYA B. , ARAS F., GENÇ İ., AKTAŞ Ö., GEREN I. N. , KURT H., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Lisansüstü Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması, 2013 - 2016

TÜRÜT A., BAŞARAN E., GÖRÜR M., COŞKUN F. M. , COŞKUN M., ŞENGEZ B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Metal/Organik bileşik/inorganik yarıiletken Kontak Yapıların elektronik ve Optik Özelliklerinin Araştırılması, 2013 - 2015

TÜRÜT A., YILDIRIM N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Saçtırma metoduyla hazırlanan Ni/n-GaN diyotların elektriksel özellikleri üzerine ısı tavlamanın etkisi, 2014 - 2014

TÜRÜT A., BAŞARAN E., TÜRKAN M., KAVAS H., KURT H., DEMİR A., ŞENGEZ B., SAĞIR F., KOYTAK Z. N. , KECECİ K., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Uluslararası Yarıiletken Bilimi ve Teknoloji Konferansı (International Semiconductor Science and Technology Conference), 2013 - 2014

KECECİ K., GÖRÜR M., TÜRÜT A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nano gözenekli sensör hazırlanması, cam kaplı elektrot üretimi ve iletken polimer sentezi, 2013 - 2014

KURT H., BAŞARAN E., KÜSKÜ S. İ. , KAVAS H., TÜRÜT A., TÜRKAN M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bilgisayar Kontrollü Sıcaklığa Bağlı Elektronik ve Manyetoelektronik Ölçüm Sistemi, 2013 - 2014

TÜRÜT A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, GaAs temelli Schottky diyotların Karakteristikleri üzerine ALD metoduyla büyütülen Al₂O₃ ince tabakasının etkisi, 2013 - 2013

TÜRÜT A., TÜBİTAK Projesi, Nanometre Kalınlıklı ReaktifMetal/III-V Yarıiletken Kontakların Potansiyel Engelinin Isıl Tavlamaya ve Numune Sıcaklığına Bağlılığı ve Bu Yapıların MESFET ve MOSFET Devre Elemanlarındaki Kullanılabilirliği Araştırılması, 2006 - 2009

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Materials Science in Semiconductor Processing, Editör, 2011 - Devam Ediyor

Turkish Journal of Physics, Editör, 2010 - Devam Ediyor

International Journal of material sciences and electronics research, Editör, 2009 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Uluslararası Yarıiletken Bilimi ve Teknolojisi Konferansı, İstanbul, Ocak, 2014

Solar Energy For World Peace, İstanbul, Ağustos, 2013

Nano-Tr-9, Erzurum, Haziran, 2013

Türk Fizik Derneği 23. Fizik Kongresi, Bodrum, Eylül, 2005

Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, ERZURUM, Mayıs, 2005

Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum, Eylül, 2004

10. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, ANKARA, Kasım, 2003

Turkish Physical Society 21th Physics Conference, ISPARTA, Ocak, 2002

Turkish Physical Society 21th Physics Conference, ISPARTA, Ocak, 2002

Hellenic Physical Society & Turkish Physical Society, First Hellenic-Turkish International Physics Conference, Bodrum, Eylül, 2001

Balkan Physics Letters, Ocak, 2001

TFD 19. Fizik Kongresi, ELAZIĞ, Eylül, 2000

YMF 2000, TFD II. Ulusal Yoğun Madde Fiziği Kongresi, ERZURUM, Haziran, 2000

TFD-18 Ulusal Fizik Kongresi, ADANA, Ekim, 1999

TFD-17 Ulusal Fizik Kongresi, Antalya, Ekim, 1998

TFD-16 Ulusal Fizik Kongresi, BALIKESİR, Ağustos, 1996

TFD-15 Ulusal Fizik Kongresi, Antalya, Eylül, 1995

TFD-13 Ulusal Fizik Kongresi, Eskişehir, Ekim, 1992

TFD-13 Ulusal Fizik Kongresi, Eskişehir, Ekim, 1992

Bilimsel Hakemlikler

Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry , Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2014
Advances in Polymer Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2014
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2014
Philosophical Magazine & Philosophical Magazine Letters, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2014
Journal of Applied Physics, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2014
Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2013
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2013
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2013
Materials Science and Engineering B, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2013
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2013
Physica B, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2013
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2013
Physica B, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2013
Journal of Physics and Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2013
superlattice and microstructure, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2013
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2013
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
Philosophical Magazine Letters, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
Physica B, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
IEEE Electron Device Letters, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
IEEE Electron Device Letters, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2013
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2013
Physica B, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2013
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2012
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2012
Journal of Nanomaterials, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2012
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2012
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2012
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2012
Physica B Condensed Matter, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2012
Indian Journal of Physics, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2012
Journal of Electronic Materials, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2012
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2012
Physica B Condensed Matter, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2012
International Journal of Electronics, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2012
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2012
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2012
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2012
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2012
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2012
Materials Science in Semiconductor Processing , SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2012
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2012
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2012

Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2012

Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2012

Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2012

Bilimsel Danışmalıklar

TÜBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, 2011 - 2012

TÜBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, 2011 - 2011

Atıflar

Toplam Atf Sayısı (WOS):4785

h-indeksi (WOS):38